

固体辐射物理研究室知识库

ALL

精确检索请加双引号

Go

首页 研究单元&专题 作者 文献类型 学科分类 知识图谱 新闻&公告

XJIPC OpenIR > 固体辐射物理研究室

一种电路级总剂量辐射效应仿真方法

郑齐文; 崔江维; 李小龙; 魏莹; 余学峰; 李豫东; 郭旗

2021-01-12

专利权人 中国科学院新疆理化技术研究所

专利类型 发明专利

摘要 本发明涉及一种电路级总剂量辐射效应仿真方法,该方法包括晶体管偏置电压提取、晶体管平均偏置电压计算、晶体管辐射陷阱电荷计算、晶体管总剂量效应模型参数更新、电路总剂量辐射损伤仿真、电路总剂量辐射损伤时间连续反馈计算。该方法的理论基础是晶体管辐射偏置条件不同,总剂量辐射损伤特性不同,进而影响电路的总剂量辐射损伤。该方法的优势在于根据电路中晶体管的偏置状态,计算晶体管总剂量辐射损伤,实现电路总剂量辐射效应的精确仿真。

申请日期 2020-10-20

申请号 CN202011125626.7

公开(公告)号 20210112

代理机构 65106 乌鲁木齐中科新兴专利事务所(普通合伙)

文献类型 **专利**

条目标识符 <http://ir.tianshanzw.cn/handle/365002/8095>

专题 固体辐射物理研究室

推荐引用方式 郑齐文,崔江维,李小龙,等.一种电路级总剂量辐射效应仿真方法. 20210112[P]. 2021-01-12. GB/T 7714

条目包含的文件

条目无相关文件。

所有评论 (0)

[发表评论/异议/意见]

暂无评论

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

个性服务

推荐该条目

- ★ 保存到收藏夹
- 👁 查看访问统计
- 📄 导出为Endnote文件

谷歌学术

- 📖 谷歌学术中相似的文章
- 📖 [郑齐文]的文章
- 📖 [崔江维]的文章
- 📖 [李小龙]的文章

百度学术

- 📖 百度学术中相似的文章
- 📖 [郑齐文]的文章
- 📖 [崔江维]的文章
- 📖 [李小龙]的文章

必应学术

- 📖 必应学术中相似的文章
- 📖 [郑齐文]的文章
- 📖 [崔江维]的文章
- 📖 [李小龙]的文章

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享

